Screening effects of coulomb interactions of C₃N compounds

13

Masoud Amiri^{*}, Hanif Hadipour

Department of Physics, University of Guilan, Rasht, Iran

Received: 18.08.2019 Final revised: 01.05.2020 Accepted: 21.09.2020 Doi link: 10.22055/JRMBS.2020.15924

Abstract

In this paper we investigate the screening effects of coulomb interaction in monolayer and bilayer C₃N and C₃NH₃ samples based on the random-phase approximation and compared with graphene and hydrogenated graphene. We calculate partially (U) and fully (W) screened, and also bare (V) interaction parameters for these compounds. In the system with more electrical conductivity the effects of the screening are greater and the parameters U and W are further reduced. In monolayer C₃N, interaction parameters are similar to those of graphene. The fully hydrogenated C_3N is also a relatively large gap in the chair-type and boat-type, and the values of interaction parameters are greater than the monolayer C_3N and hydrogenated graphene values. In the bilayer C₃N with metallic behavior, there's a large screening that makes it a correlated system.

Keywords: Energy gap, Screening effects, Coulomb Interaction, Random phase approximation



اثرات استتاری اندر کنشهای کولنی ترکیبات C₃N

مسعود امیری *، حنیف هادی پور

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

دريافت: 1398/05/27 ويرايش نهايي: 1399/02/12 پذيرش: 1399/06/31 Doi link: 10.22055/JRMBS.2020.15924

چکیدہ

در این مقاله اثرات استتاری نیروی کولنی در نمونههای تکلایه و دولایه C₃N و C₃NH و C₃NH را بر اساس تقریب فاز تصادفی بررسی و با گرافن و گرافن هیدروژنه مقایسه میکنیم. ما پارامتر اندرکنش کولنی جزیی استتارشده (U)، کامل استتارشده (W) و پارامتر اندرکنش کولنی بدون استتار (V) را برای این ترکیبات محاسبه میکنیم. در سیستم با هدایت الکتریکی بیشتر، اثرات پوششی بیشتر بوده و پارامترهای U و W بیشتر کاهش مییابد. در C₃N تکلایه پارامترهای اندرکنشی مشابه گرافن شاهد هستیم. برای C₃N هیدروژنه شده که در دو ساختار صندلی و قایق یک نیمرسانا با گاف نسبتاً بزرگ است، مقادیر پارامترهای اندرکنشی بهدستآمده بیشتر از مقادیر C₃N و گرافن هیدروژنه بود. اما در C₃N دولایه با توجه به رفتار فلزی آن، استتار اندرکنشهای کولنی را شاهد هستیم که آن را تبدیل به یک سیستم همبسته میکند.

كليدواژگان: گاف انرژى، اثرات استتارى، تقريب فاز تصادفى، اندركنش كولنى

مقدمه

در سالهای اخیر پس از ساخت گرافن مطالعات زیادی بر زیادی روی ترکیبات کربنی انجام شده است [1,2]. این عناصر دی ساختار به دلیل ویژگی های خاص خود کاربرد زیادی گرافن، ج در صنایع مختلف پیدا کرده است. گرافن با وجود نازک است. در بودن، به علت نیروی بسیار زیاد پیوندهای کووالانسی، صورت 2 بودن، به علت نیروی بسیار زیاد پیوندهای کووالانسی، صورت 2 بسیار مقاوم و مستحکم بوده و رسانایی آن بسیار زیاد است. اما این مطالعات برای برنامه های کاربردی خاص وجود اتم با چالش ها و مسائلی (عمدتاً ناشی از طبیعت بدون در خوام گاف انرژی) روبرو شد [3]. این محدودیت های پایدارتریر گرافن در کاربردهای عملی، سبب شد تلاش های

زیادی برای گسترش خانواده گرافن ساختهشده از عناصر دیگر انجام گیرد. یک روش تغییر در ساختار گرافن، جایگزینی اتمهای کربن با اتمهای نیتروژن است. در سال 2015 یک ماده جدید به نام C₃N به صورت 2 و3 بعدی ساختهشد [4]. اگرچه شباهت زیادی بین صفحات C₃N و گرافن وجود دارد، اما وجود اتمهای نیتروژن باعث بروز تفاوتهای برجسته در خواص الکترونیکی آن میشود [5]. C₃N پایدارترین ساختار در بین ترکیبات C_xN است [6].

^{*}نويسنده مسئول : Mt.amiri90@gmail.com



الکترونیکی نه تنها نقش مهمی در ساخت نانوابزارها دارد بلکه می تواند در کاربردهای جدید دیگری هم استفاده شود [7]. رسانندگی گرمایی صفحات C₃N نسبت به گرافن کمتر است که آن را گزینه خوبی برای کاربردهای ترموالکتریکی می سازد [8]. گافی بهاندازهٔ کاربردهای ترموالکتریکی می سازد [8]. گافی بهاندازهٔ مشاهده شد که هرگز در مواد 2 بعدی بر پایهٔ کربن وجود نداشته است و این خبر خوبی برای رفع مشکل طبیعت بدون گاف گرافن بود که نشانگر نقش مهم نیتروژن می باشد.

روش دیگر، جذب هیدروژن روی C₃N تکلایه میباشد که در آن هر اتم کربن به یک اتم هیدروژن با فرمول C₃NH₃ متصل میشود. تکلایههای C₃NH₃ دارای پایداری حرارتی خوبی بوده و نقطهٔ ذوب آنها بالاتر از *X*500 است [9]. گاف بهدست آمده در نمودار چگالی حالات این ترکیب به اندازه V9 9/8 در C₃NH₃ حالت صندلی و V9 8/2 در C₃NH₃ حالت قایق نشاندهنده رفتار نیمرسانایی آنها می باشد.

در سیستمهای با ابعاد کم همبستگی الکترونی اهمیت زیادی دارد. اثرات همبستگی الکترونی در موادی مثل گرافن [10] و گرافن هیدروژنه مشاهده شدهاست الا-11]. همچنین برای افرادی که از هامیلتونی مدل استفاده میکنند اطلاع از مقدار پارامتر U دارای اهمیت زیادی است. پس بررسی اثرات استتاری ترکیبات C₃N و تعیین شدت موثر اندرکنش کولنی عمل کننده بر روی الکترونها از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور حل هامیلتونی مدل هابارد، محاسبه مقدار U ضروری است. روشی بر پایه تقریب فاز تصادفی برای

محاسبه U در سالهای اخیر پیشنهاد شد [13]. پارامتر U به اثرات استتاری الکترونهای درونی مربوط است. بزرگی اندرکنشهای کولنی بلند برد (U(r) نیز نقشی بسیار مهم در تعیین شدت همبستگی الکترونی و طبقهبندی مواد دارد [15-14].

در مقالات گذشته اثرات استتاری اندرکنش های کولنی در نانونوارهای گرافنی و ارتباط آن با پهنای نانونوار [10]، پارامترهای اندرکنشی گرافن هیدروژنه و ارتباط آن با ویژگیهای مغناطیسی [11]، همچنین اثرات استتاری در گرافن شامل تهیجای و ویژگیهای مغناطیسی آن را بررسی کردیم [12]. در نانونوار گرافنی با لبه دستهصندلی اثرات محدودیت کوانتومی منجر به رفتار نوسانی پارامترهای اندرکنش کولنی موضعی با پهنای نوار شد. همچنین کاهش ابعاد و وجود گاف کوچک منجر به استتار اندرکنشها در فواصل کوچک، و رفتار ضد استتاری در فواصل میانه و اندرکنش کولنی ساده در فواصل دورتر شد. در نانونوار گرافنی با لبه زیگزاگ حضور حالتهای لبه بهشدت بر اندرکنشها تأثیر گذاشت که موجب کاهش شدید پارامتر U هابارد شد و بخش غیرموضعی اندرکنش ها توسط حالتهای لبهای استتار شد و این موضوع نانونوار گرافن با لبه زیگزاگ را تبدیل به ماده همبسته میکند. در گرافن هیدروژنه پارامترهای اندرکنشی را کمتر از گرافن محاسبه کردیم. این پارمترها بهشدت به تعداد اتمهای هیدروژن و جایگاه اتمهای هیدروژن جذبشده در شبکه گرافن بستگی دارد. همچنین جایگاه متفاوت هیدروژن به رفتار متفاوت مغناطیسی در این ماده منتج میشود.

در این مقاله با استفاده از تقریب فاز تصادفی مقادیر پارامترهای اندرکنشی برای C_3N تکلایه، C_3N دولایه و C_3NH_3 بهدستآمد. با مقایسه پارامتر اندرکنشی U گرافن و C_3N تکلایه دریافتیم که پارامترU این دو ماده تقریباً هماندازه و بزرگ است. طبق انتظار در گرافن که دارای ساختار نواری مخروطی شکل است مانند C_3N تکلایه، استتار اندرکنشهای کولنی ضعیف است. با محاسبه پارامترهای اندرکنشی C_3NH_3 و مقایسه آنها با پارامترهای اندرکنشی C_3NH_3 و مقایسه آنها با پارامترهای اندرکنشی C_3N و گرافن هیدروژنه متوجه پارامترهای اندرکنشی که دارای و با توجه به رسانایی شدیم مقدار پارامتر U در ترکیبات C_3NH_3 از آنها انکتریکی آن، مقدار خیلی کم پارامتر U نشاندهنده استتار اندرکنش کولنی بود که میتوان آن را به عنوان

روش محاسبات

C₃N شامل یک شبکهٔ لانهٔ زنبوری دوبعدی با توزیع همگن و مرتب اتمهای نیتروژن است. اتمهای نیتروژن خودشان یک شبکهٔ لانه زنبوری دو بعدی با ثابت شبکه دو برابر تشکیل میدهند. ساختارهای شبیه دو برابر تشکیل میدهند. ساختارهای میدهند. ساختارهای میدهند. ساختارهای حالت صندلی و قایق در شکل 1 نشان داده شده است. برای شبیه سازی ساختارها از سلول واحد هگزاگونال برای شبیه سازی ساختارها از سلول واحد هگزاگونال استفاده کردیم و ثابتهای شبکهٔ همهٔ آنها 1866 آنگستروم لحاظ شده است. برای جلوگیری از اندرکنش لایه ها، بین آنها یک گاف خلاً به اندازهٔ 20 آنگستروم در نظر گرفته شد. برای بهینه سازی ساختارها میک مرحله محاسبات بهینه سازی انجام شد به طوری

که نیرو و استرس وارد بر هر اتم کمتر از 0/02 eV/A⁰ تسود. برای همهٔ اتمها از شبه پتانسیل فوق نرم استفاده شد. شبکهٔ نقاط K در جهت دوره ای در محاسبات نظریهٔ تابعی چگالی با کد FLEURE برای C₃N نظریهٔ تابعی چگالی با کد C₃NH برای تک لایه، C₃N دولایه و C₃NH به تر تیب 1×24×24 اک 21×21، 1×03 ×00 و در محاسبات SPEX برای همهٔ ساختارها 1×10×10 در نظر گرفته شد.



شكل C₃NH₃ .d تكاليه C₃NH₃ .c دولايه C₃NH₃ .d صندلى قايق. قايق.

تکنیک تقریب فاز تصادفی روشی برای محاسبه پارامترهای اندرکنش کولنی مؤثر است که به ما امکان میدهد تا عناصر ماتریس کولنی را مشخص کنیم [15]. در این روش تابع قطبش را به دو بخش P_c و P_r تقسیم میکنیم. P_z فقط شامل گذار بین حالتهای P_z است و P_r هم مربوط به بقیه گذارها می باشد. $P = P_z + P_r$

17	اثرات استتاری اندرکنش های کولنی	مسعود امیری و حنیف هادی پور
اندركنش كولني	مؤثر موضعی (U) با رابطهٔ زیر	بهبودیافته خطی با پتانسیل کامل استفاده میشود. برای
تعريف مي شود:		اجرای این کد به ویژهمقادیر و ویژهحالتهای همگرا
2	$U = \left[1 - VP_r\right]^{-1} V$	شده نیاز داریم، پس محاسبات نظریهٔ تابعی چگالی را
که در آن <i>V</i> اند	درکنش کولنی ساده است. پارامتر	بر اساس تقریب شیب تعمیمیافته PBE [16] برای
اندرکنش کولنی م	موضعی یوششی کامل (W) با رابطهٔ	محاسبهٔ ویژهمقادیر و ویژهتوابع همگراشده در بسته
زېږېدان مې شود:		SPEX توسط كد FLEUR انجام ميدهيم. از قطع
	1	ممنتوم خطی ¹ - G _{max} =4/5 Bohr برای امواج تخت
3	$W = \left[1 - UP_z\right]^T U$	و قطع ممنتوم زاویهای L _{max} =6 برای کرههای
با استفاده از توابع	ع وانیر جایگزیده بیشینه در مکان <i>R</i>	مافين تين استفاده مىكنيم. محاسبات نظريهٔ تابعى
با اربیتال <i>n</i> (<i>r</i>)،	W _n K، عناصر ماتریس پتانسیل کولنی	چگالی بهعنوان ورودی برای کد SPEX استفاده
مۇثر U بەصورت	، زیر مطرح میشود:	میشود [17] تا محاسبات تقریب فاز تصادفی برای
$ n_3n_4\rangle = 4$	$U_{Rn_1n_2n_3n_4}(\omega) = \langle n_1n_2 U(\omega) n_1 \rangle$	محاسبهٔ پارامتر U هابارد انجام شود [18،19]. توابع
)	$\iint W^*_{n_1R}(r)W^*_{n_2R}(r')U(r,r';\omega)$	وانیر نقش اساسی در محاسبهٔ ماتریس های کولنی دارد.
	$W_{n_{3}R}(r)W_{n_{4}R}(r')d^{3}rd^{3}r'$	در واقع کد اسپکس بهکمک کد Wannier90 از
عناصر ماتریس ک	ئولنی مؤثر میانگین توسط رابطهٔ زیر	ویژهتوابع بلاخ، توابع وانیر را میسازد و در
بيان مىشود:		انتگرال،های کولنی استفاده میکند [20]. پس از این
5	1	مرحله برای اجرای بخش اصلی کد SPEX مواردی
5	$U = \frac{1}{L} \sum_{n=m}^{\infty} U_{nm;nm}$	نظیر تقسیمبندی نقاط K، نوع محاسبه، مقدار آستانه
		بهمنظور حذف ضرايب تابع موج و نوع اربيتال همبسته
که در آن <i>L</i> تعد	.اد اربیتال.های موضعی است. برای	را تعیین میکنیم.
بررسی میزان هم	مبستگی موجود در C ₃ N و تعیین	جبنه منابع
شدت مؤثر برھ	مکنش کولنی عملکننده بر روی	
الكترونها، مقادي	یر پارامترهای اندرکنشی موضعی	در هامیلتویین مدل و برای پیش بینی ویژ دی های

جزیی (U) و کامل (W) و برهمکنش کولنی بدون

استتار (V) را با استفاده از بسته محاسباتی SPEX و

بر اساس تقريب فاز تصادفي محاسبه ميكنيم.

بسته SPEX یک کد محاسباتی بر پایه نظریه اختلال

بسذرهای بوده که در آن از روش امواج تخت

در هامیلیویین مدل و برای پیسبیبی ویزدی های اپتیکی، الکترونیکی و مغناطیسی ترکیبات C₃N اطلاع از مقدار پارامتر اندرکنشی *U* هابارد برای افراد از اهمیت زیادی برخوردار است. پس ما با محاسبه اندرکنشهای موضعی سیستمهای C₃N تکلایه، دولایه و C₃NH3 شروع میکنیم.

	V(bare)(eV)	<i>U</i> ₀₀ (eV)	$W_{00}(\mathrm{eV})$	
گرافن	16 _/ 7	8,7	5,7	
C3N تىكلايە	17/9	8,6	4/9	
C ₃ NH ₃ صندلی	18,9	9,9	8,0	
C ₃ NH ₃ قايق	21,7	10 _/ 9	9,0	
C3N دولايه	17/9	4/3	3/9	

جدول1. پارامترهای اندرکنشی موضعی بدون استتار(bare). جزیی و کامل استتارشده (cRPA) اتم کربن.

C₃N ممانطور که در جدول ا نشان داده شده در C₃N تکلایه نیز همانند گرافن [11]، استتار ضعیف است و مقدار بزرگی برای U بهدست آمدهاست. پارامترهای اندرکنشی موضعی گرافن (V = 8,7eV) و C₃N و C₃N تکلایه تفاوت کمی با هم دارند که با گاف کوچک robbe در C₃N در C₃N و مقارت کمی با هم دارند که با گاف کوچک robbe در C₃N در C₃N و مقارت کمی با هم دارند که با گاف کوچک robbe در C₃N در C₃N در C₃N و مقارت کمی با هم دارند که با گاف کوچک robbe در C₃N در C₃N در C₃N در C₃N و مقارت کمی با هم دارند که با گاف کوچک robbe در C₃N در C₃N

اما در مورد C₃N دولایه، شکل (b-2) نشان میدهد که اربیتالهای p_z روی سطح فرمی نقش عمده دارند، و با توجه به رفتار فلزی که در شکل(c-2) و ساختار نوار انرژی در شکل (d-b) شاهد هستیم انتظار میرود که استتار کولنی دو الکترون قرار گرفته در یک مکان

نسبت به C₃N تکلایه بیشتر باشد که مقایسه پارامترهای U و W بهدست آمده در جدول1 برای C₃N دولایه نشاندهنده این موضوع است.

اما در مورد C₃NH₃ حالت صندلی و حالت قایق جذب اتمهای هیدروژن توسط اتمهای کربن منجر به ایجاد گاف در نمودار چگالی حالات شده و سیستم را به عایق تبدیل می کند (شکل های c-3 و a-3). در شکل (4-a) نمودار ساختار نواری C₃N تکلایه نشان داده شدهاست که دارای گاف انرژی کوچکی اطراف سطح فرمی است و توافق خوبی با چگالی حالات انرژی دارد. نوارها نسبتاً پهن بوده و این سبب میشود که نسبت U/W که معیاری از همبستهبودن الکترونهاست کوچک باشد و سیستم را در ناحیه همبستگی متوسط قرار میدهد. در مورد ساختار نواری C₃N دولایه شکل(4b)، کمی نوارها تخت تر هستند و این می تواند سیستم را در ناحیهٔ همبستهٔ قوی قرار دهد. با توجه به ساختار نوار انرژی در شکلهای(4c و 4d)، نوارهای انرژی در اطراف انرژی فرمی از هم فاصله گرفته و در C₃NH3 حالت صندلی دارای گاف غیرمستقیم 3/9eV میباشد که بیشینه نوار ظرفیت در نقطهٔK و کمینه نوار رسانش در نقطه Γ واقع است. 2/8eV حالت قایق هم دارای گاف مستقیم C_3NH_3 است. این گاف نواری مستقیم برای کاربردهای فوتوكاتالیستی و جذب نوری ضروری است.



d. چگالى حالات تصوير شدە C3NH3 قايق.

اکنون در مورد برهم کنش های بلندبرد صحبت خواهیم کرد. با توجه به پارامترهای اندرکنشی بلندبرد بهدست آمده در جدول2 پارامتر اندرکنش کولنی نزدیکترین همسایگی برای C₃N تکلایه برابر 4/3 eV نزدیکترین همسایگی برای T₃N تکلایه برابر 9 و برای C₃N دولایه، برابر 1/5eV است که این مقدار نشانگر استتار اندرکنش کولنی در C₃N دولایه می باشد که رفتار فلزی ماده (شکل2c) این مطلب را تأیید می کند.

در C₃N دولایه پارامتر اندرکنشی بلند برد تا همسایگی سوم به مقدار خیلی کوچک 0/1 eV می رسد. این گونه سیستمها که در آنها افت ناگهانی پارامتر اندرکنشی بلندبرد وجود دارد، همبسته نامیده می شوند. برخلاف C₃N تکلایه، برای بررسی ویژگیهای C₃N دولایه که سیستمی همبسته می باشد تقریبهای چگالی موضعی و شیب تعمیمیافته ناکافی است و تقریبهای فراتر از اینها نیاز خواهد شد.



سمل د. ۸. چکالی خارک دل ۲۵۰ کالی مار چکالی خارک تصویرشده C₃N تکلایه c. چگالی حالات کل C₃N دولایه d. چگالی حالات تصویرشده C₃N دولایه.

در C_3NH_3 مقادیر پارمترهای اندرکنشی موضعی U و C_3NH_3 به دست آمده از مقادیر مربوط به C_3NH_3 تکلایه بزرگ تر است، که در توافق با گاف بزرگ و رفتار عایق گونه C_3NH_3 است. همچنین مقدار این پارامترها از مقادیر مربوط به گرافن هیدروژنه در کار قبلی ما بیشتر است که در گرافن نیمه هیدروژنه برابر U برابر 4/3eV و در گرافن تمام هیدروژنه برابر 9/8eV بود [11].

جدول2. پارامترهای اندرکنشی موضعی و بلندبرد بدون استتار (bare). جزیی استتارشده (CRPA) اتم کربن.

	C3N تکلایه		دولايه	C3N
	Bare	cRPA	Bare	cRPA
$U_{00} (\mathrm{eV})$	17/9	8,6	17/9	3/9
$U_{0l} (\mathrm{eV})$	8,7	4/3	10/1	1,5
$U_{02} (\mathrm{eV})$	5,4	2/9	5,4	0/2
U_{03} (eV)	4,8	2 _/ 7	3,7	0/1

جدول3. پارامترهای اندرکنشی موضعی و بلندبرد بدون استتار (bare)،

جزئی استتارشدہ (cRPA) اتم کربن

	C3NH3 صندلى		C قايق_	3NH3
	Bare	cRPA	Bare	cRPA
<i>U</i> ₀₀ (eV)	18,9	9/9	21 _/ 7	10,9
U_{0l} (eV)	15,4	6,8	16,7	7,8
$U_{02}({ m eV})$	14,2	6,4	15 _/ 1	7,3
U ₀₃ (eV)	5,9	2,8	5,0	2/9



شكل4. ساختار نوار انرژی C₃N .a تكلایه C₃N b دولایه C₃NH₃ .c دولایه c₃NH₃ .c صندلی d. C₃NH₃ .d

اما در مورد C₃NH₃ با توجه به جدول S کاهش پارامتر اندرکنش کولنی با افزایش فاصله، از C₃N تکلایه، دولایه و گرافن نامحسوس تر است، به طوری که تا همسایگی سوم مقدار قابل توجه V9 8/2 برای حالت صندلی و V9 9/2 برای حالت قایق نشان میدهد. بدیهی است گاف بزرگتر C₃NH₃ و نیز رفتار عایق گونه آن در این موضوع اثر گذار بوده است، هر چند حضور اتم های هیدروژن در بالای اتم های کربن سبب دخالت همه اربیتال ها (sp³) در سطح فرمی شکل های

نتيجه گيري

ما استتار اندر کنش های کولنی موضعی و بلندبرد الکترون های ترکیبات C₃N را با به کارگیری تقریب فاز تصادفی مطالعه کردیم. با مقایسه پارامتر اندر کنشی *U* دریافتیم این پارامتر در C₃N تکلایه نسبت به گرافن تفاوت چندانی ندارد و در واقع جایگزینی نیتروژن با کربن لااقل در این مورد تقریباً بی اثر بوده است. با محاسبه پارامترهای اندرکنشی C₃NH₃ و مقایسه آنها با پارامترهای اندرکنشی C₃NH₃ و مقایسه آنها با پارامترهای شدیم که مقادیر پارامترها نسبت به C₃N و گرافن شدیم که مقادیر پارامترها نسبت به C₃N و گرافن میدروژنه بیشتر و قابل توجه است که این موضوع در ارتباط مستقیم با گاف بزرگ C₃NH₃ و رفتار عایق گونه آن است. در مورد C₃N و رفتار محاسبات نشاندهنده استتار اندرکنش های کولنی [4] M. Bagheri, Electrical and mechanical properties of a fully hydrogenated twodimensional polyaniline sheet, Computational *Materials Science* **153** (2018) 126-133.

https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2018.0 6.027

[5] M. Bagheri, S. Izadi, Polyaniline (C₃N) nanoribbons: Magnetic metal, Semiconductor, and Half-Metal, *Applied physics* **124** (2018) 84304.

https://doi.org/10.1063/1.5042207

[6] H.J. Xiang, B. Huang, Z.Y. Li, S.H. Wei, J.L. Yang, X.G. Gong, Ordered Semiconducting Nitrogen-Graphene Alloys, *Physical Review* X **2** (2012) 11003.

https://doi.org/10.1103/PhysRevX.2.01100 3

[7] B. Mortazavi, Ultra high stiffness and thermal conductivity of graphene like C_3N , *Carbon* **118** (2017) 25-34.

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.02 9

[8] S. Kumar, S. Sharma, V. Babar, U. Schwingenschlogl, Ultralow lattice thermal conductivity in monolayer C₃N as compared to graphene, *Materials Chemistry* A **5** (2017) 407-411.

https://doi.org/10.1039/C7TA05872A

[9] D. Wang, Y. Bao, T. Wu, S. Gan, D. Han, L. Niu, First-principles study of the role of strain and hydrogenation on C₃N, *Carbon* **134** (2018) 22-28.

https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.03.06 8

[10] H. Hadipour, E. Sasıoglu, F. Bagherpour, C.Friedrich, S. Blugel, I. Mertig2, Screening of the long-range Coulomb interaction in graphene nanoribbons: Armchair versus zigzag edges *Physical Review* B **98** (2018) 205123.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.98.20512 3

ترکیب تعویض اتمهای کربن با نیتروژن با توجه به دولایه بودن آن سبب ایجاد رفتار فلزی و کاهش پارامترهای اندرکنشی شدهاست. همچنین در این ماده يارامتر اندركنشي بلندبرد تا همسايگي سوم به طور ناگهانی به مقدار 0/1 eV می رسد. به سبب این رفتار می توان آن را به عنوان یک سیستم همیسته در نظر گرفت که برای بررسی آن تقریبات چگالی موضعی و شیب تعمیمیافته کامل نخواهد بود و نیاز به تصحیحات بیشتری می باشد. يارامترهاى اندركنشى محاسبهشده بهطور قابل توجهي توانايي پيش بيني هاميلتونين مدل براي ویژگیهای مغناطیسی، ایتیکی و الکترونیکی را افزایش میدهد. پارامترهای مدل هامیلتونی از محاسبات اوليه بهدست مي آيد و يا دادهاي تجربي موجود مقايسه مي شود كه سبب افزايش توان ييش گويي مدل مي شود.

اثرات استتاری اندر کنش های کولنی ...

مرجعها

[1] A.K. Geim, K.S. Novoselov, The rise of graphene, *Nature Materials* **6** (2007) 183–191.

https://doi.org/10.1038/nmat1849

[2] M.I. Katsnelson, Graphene: carbon in two dimensions, *Materialstoday* **10** (2007) 20-27.

https://doi.org/10.1016/S1369-7021(06)71788-6

[3] Y. Wu, W. Xia, W. Gao, F. Jia, P. Zhang, W. Ren, Quasiparticle electronic structure of honeycomb C₃N: from monolayer to bulk, *2D material* **6** (2018) 15-18.

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/20 53-1583/aaeeaa electron FLAPW method, *Physical Review* B **81** (2010) 125102.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.81.12510 2

[18] D.K. Singh, A. Thamizhavel, J.W. Lynn, S.K. Dhar, T. Hermann, Multiple magnetic structures of correlated Ce ions in intermetallic CeAu₂Ge₂, *Physical Review* B **86** (2012) 60405.

http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.86.060 405

[19] M. Makaremi, B. Mortazavi, C. Veer Singh. Adsorption of Metallic, Metalloidic, and Nonmetallic Adatoms on Two-Dimensional C₃N, *Physical Chemistry* **121** (2017) 575-583.

http://doi.org/10.1021/acs.jpcc.7b04511

[20] F. Freimuth, Y. Mokrousov, D. Wortmann, S. Heinze, S. Blugel. Maximally localized Wannier functions within the FLAPW formalism, *Physical Review* B **78** (2008) 035120.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.035120

[21] Q. Wei, Q. Zhang, H. Yan, M. Zhang, Cubic C₃N: A New Superhard Phase of Carbon-Rich Nitride, *Materials* **9** (2016) 840-846.

https://doi.org/10.3390/ma9100840

[11] E. Sasıoglu, H. Hadipour, C. Friedrich, S. Blugel, I. Mertig, Strength of effective Coulomb interactions and origin of ferromagnetism in hydrogenated graphene, *Physical Review* B **95** (2017) 60408.

http://doi.org/10.1103/PhysRevB.95.06040 8

[12] H. Hadipour, Screening of Coulomb interaction and π magnetism in defected graphene, *Physical Review* B **99** (2019) 75102.

https://doi.org/10.1103/PhysRevB.99.07510 2

[13] F. Aryasetiawan, M. Imada, A. Georges, G. Kotliar, S. Biermann, A.I. Lichtenstein, Frequency-depenent local interactions and loe-energy effective models from electronic structure calculations, *Physical Review*, B **70** (2004) 195104.

http://doi.org/10.1103/PhysRevB.70.19510 4

[14] S. Yang, W. Li, C. Ye, G. Wang, H. Tian, C. Zhu, P. He, G. Ding, X. Xie, Y. Liu, Y. Lifshitz, S. Lee, Z. Kang, M. Jiang, C₃N —A2D Crystalline, Hole-Free, Tunable-Narrow-Bandgap Semiconductor with Ferromagnetic, *Advanced Material* 29 (2017) 1605625.

https://doi.org/10.1002/adma.201605625

[15] J. van den Brink, G.A. Sawatzky, Nonconventional screening of the Coulomb interaction in low-dimensional and finitesize system, *Europhysics Letters* **50** (2000) 447-453.

https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00290-6

[16] J.P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, Generalized Gradiant Approximation Made Simple, *Physical Review Letters* **78** (1997) 3865.

<u>https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.78.139</u> <u>6</u>

[17] C. Friedrich, S. Bl⁻ugel, A. Schindlmayr, Efficient implementation of the GW approximation within the all

22